

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

BSKB
(703) 205-8000
0171-1062P.
Nanada et al.
2-9-94 New
1081

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日、 2003年 2月10日
Date of Application:

出願番号 特願 2003-032675
Application Number:

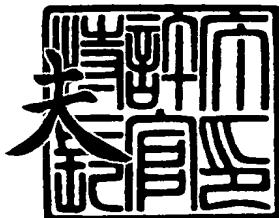
[ST. 10/C] : [JP 2003-032675]

出願人 信越化学工業株式会社
Applicant(s): 松下電器産業株式会社
セントラル硝子株式会社

2003年12月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 15042

【提出日】 平成15年 2月10日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G03F 07/039

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 原田 裕次

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 畠山 潤

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 河合 義夫

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1006 番地

【氏名】 笹子 勝

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1006 番地

【氏名】 遠藤 政孝

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1006 番地

【氏名】 岸村 真治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 セントラル硝子株式会社内

【氏名】 前田 一彦

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株式会社 化学研究所内

【氏名】 小森谷 治彦

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株式会社 化学研究所内

【氏名】 宮澤 覚

【特許出願人】

【識別番号】 000002060

【氏名又は名称】 信越化学工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000002200

【氏名又は名称】 セントラル硝子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079304

【弁理士】

【氏名又は名称】 小島 隆司

【選任した代理人】

【識別番号】 100114513

【弁理士】

【氏名又は名称】 重松 沙織

【選任した代理人】

【識別番号】 100120721

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 克成

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

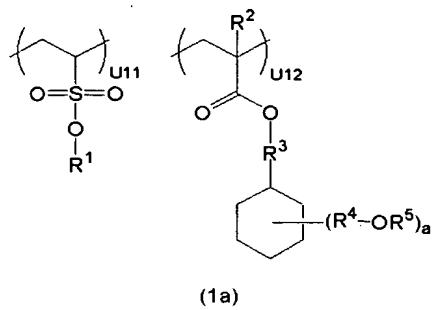
【書類名】 明細書

【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法

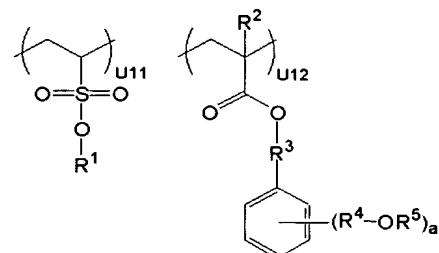
【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1a)又は(1b)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

【化1】



(1a)

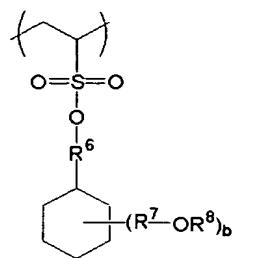


(1b)

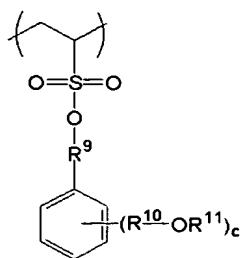
(式中、 R^1 は酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 R^2 は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 R^3 及び R^4 は単結合、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。 R^5 は水素原子又は酸不安定基である。 a は1又は2である。 $0 < \text{U11} < 1$ 、 $0 < \text{U12} < 1$ である。)

【請求項2】 上記一般式(1a)及び(1b)中のスルホン酸エステルユニットが下記一般式(2a)~(2f)から選ばれるものであることを特徴とする請求項1記載の高分子化合物。

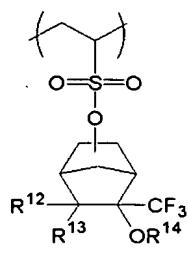
【化2】



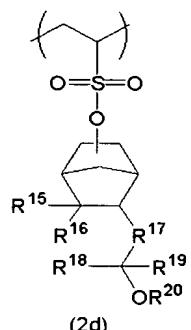
(2a)



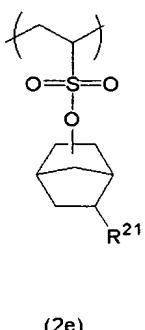
(2b)



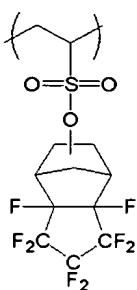
(2c)



(2d)



(2e)

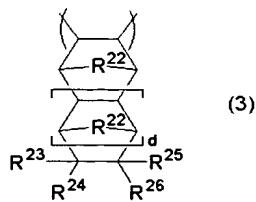


(2f)

(式中、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰及びR¹⁷は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R⁸、R¹¹、R¹⁴及びR²⁰は水素原子又は酸不安定基である。R¹²、R¹³、R¹⁵、R¹⁶、R¹⁸、R¹⁹は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹⁸又はR¹⁹の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。R²¹は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。b及びcはそれぞれ1又は2である。)

【請求項3】 下記一般式(3)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の高分子化合物。

【化3】



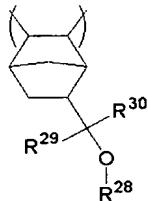
(3)

(式中、R²²はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R²³～R²⁶は、水

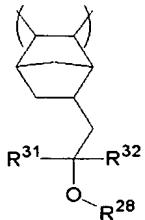
素原子、フッ素原子、 $-R^{27}-OR^{28}$ 、 $-R^{27}-CO_2R^{28}$ 、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{23} \sim R^{26}$ のうち少なくとも一つは、 $-R^{27}-OR^{28}$ 又は $-R^{27}-CO_2R^{28}$ を含む。 R^{27} は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。 R^{28} は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 d は0又は1である。)

【請求項4】 上記一般式(3)で表される繰り返し単位が下式(3a)又は(3b)で表される構造であることを特徴とする請求項3記載の高分子化合物。

【化4】



(3a)

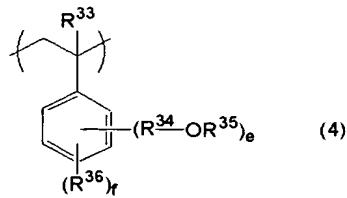


(3b)

(式中、 R^{28} は上記と同様である。 $R^{29} \sim R^{32}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 R^{29} 及び R^{30} の少なくともどちらか一方、 R^{31} 及び R^{32} の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

【請求項5】 更に、下記一般式(4)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の高分子化合物。

【化5】

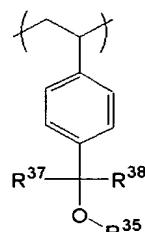


(式中、 R^{33} は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状も

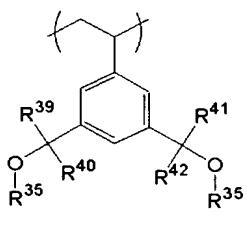
しくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R³⁴は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R³⁵は水素原子又は酸不安定基である。R³⁶はフッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。eは1又は2、fは0～4の整数であり、 $1 \leq e + f \leq 5$ である。)

【請求項 6】 上記一般式（4）で表される繰り返し単位が下式（4 a）又は（4 b）で表されることを特徴とする請求項 5 記載の高分子化合物。

【化6】



(4a)

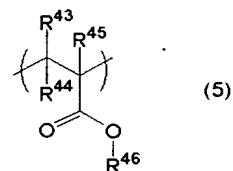


(4b)

(式中、R³⁵は上記と同様である。R³⁷～R⁴²はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R³⁷及びR³⁸の少なくともどちらか一方、R³⁹及びR⁴⁰の少なくともどちらか一方、R⁴¹及びR⁴²の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

【請求項7】 更に、下記一般式(5)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の高分子化合物。

【化7】



(5)

(式中、R⁴³～R⁴⁵は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R⁴⁶は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。)

【請求項8】 上記一般式(5)におけるR45がトリフルオロメチル基であ

ることを特徴とする請求項7記載の高分子化合物。

【請求項9】 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項10】 (A) 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の高分子化合物、

(B) 有機溶剤、

(C) 酸発生剤

を含有することを特徴とする化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項11】 更に塩基性化合物を含有する請求項10記載のレジスト材料。

【請求項12】 更に溶解阻止剤を含有する請求項10又は11記載のレジスト材料。

【請求項13】 (1) 請求項9乃至12のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、

(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100～180nm帯又は1～30nm帯の高エネルギー線で露光する工程と、

(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項14】 前記高エネルギー線がF₂レーザー、Ar₂レーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項13記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、微細加工技術に適したレジスト材料、特に化学增幅レジスト材料のベース樹脂として有用な高分子化合物、更にはその原料モノマーとなるスルホン酸エステル化合物、並びにこれらのレジスト材料を用いたパターン形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められている。

微細化が急速に進歩した背景には投影レンズの高NA化、レジスト材料の性能向上、短波長化が挙げられる。レジスト材料の高解像度化及び高感度化に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化学增幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するものであり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジスト材料になった（特許文献1，2：特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等に記載）。

【0003】

また、i線（365nm）からKrF（248nm）への短波長化は大きな変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミクロンルールを経て、現在0.18ミクロンルールの量産化への適用へと展開している。更には、0.10ミクロンルール以下の検討も始まっており、微細化の勢いはますます加速されている。

【0004】

ArF（193nm）では、デザインルールの微細化を0.13μm以下にすることが期待されているが、ノボラック樹脂やポリビニルフェノール系等の従来用いられていた樹脂が193nm付近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いることができない。そこで透明性と必要なドライエッチング耐性の確保のため、アクリル樹脂やシクロオレフィン系の脂環族系の樹脂が検討されている（特許文献3～5：特開平9-73173号、特開平10-10739号、特開平9-230595号公報、WO97/33198）。

【0005】

F₂（157nm）に関しては0.10μm以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がますます困難になり、ArF用ベースポリマーであるアクリル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系においてもカルボニル結合を有するものは強い吸収を持つことがわかった。また、KrF用ベースポリマーのポリビニルフェノールについては、160nm付近に吸収のウインドウがあり、若干透過率が向上するものの、実用的なレベルには程遠いことが判明した。

【0006】

このように157nm付近ではカルボニル基や炭素-炭素間二重結合が吸収を持つため、これらのユニットを低減化することも透過率向上の一つの有効な方法と考えられる。しかし、最近の研究によりベースポリマー中へフッ素原子を導入するとF₂領域での透明性が飛躍的に向上することがわかつってきた。

【0007】

例えば、SPIE2001 講演番号4345-31「Polymer design for 157nm chemically amplified resists」（非特許文献1）において、 α -トリフルオロメチルアクリル酸tert-ブチルと5-(2-ヒドロキシ-2,2-ビストリフルオロメチル)エチル-2-ノルボルネンとの共重合体、及び α -トリフルオロメチルアクリル酸tert-ブチルと4-(2-ヒドロキシ-2,2-ビストリフルオロメチル)メチルスチレンとの共重合体を用いたレジスト材料は、157nmにおけるポリマーの吸光度が3程度まで向上することが報告された。しかしながら、F₂露光により膜厚2000Å以上で矩形なパターンを得るために2以下の吸光度が必要と考えられるため、上記の樹脂ではまだ透明性が不十分である。

【0008】

また、本発明者の鋭意検討の結果、上記の α -トリフルオロメチルアクリル酸エステルのポリマー系に含フッ素ビニルスルホン酸エステルユニットを組み込むと、樹脂の基板密着性や現像液親和性を確保しつつ、透明性が向上することを見出しているが、この系にしても吸光度は2程度にとどまっている。

【0009】

【特許文献1】

特公平2-27660号公報

【特許文献2】

特開昭63-27829号公報

【特許文献3】

特開平9-73173号公報

【特許文献4】

特開平10-10739号公報

【特許文献5】

特開平9-230595号公報

【特許文献6】

国際公開第97/33198号パンフレット

【特許文献7】

特開2001-146505号公報

【非特許文献1】

SPIE2001 講演番号4345-31

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300nm以下、特にF₂ (157nm)、Kr₂ (146nm)、KrAr (134nm)、Ar₂ (126nm) 等の真空紫外光における透過率に優れたレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料、そのベース樹脂として有用な新規高分子化合物並びにこれを含むレジスト材料を用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

【0011】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、スルホン酸エステル側鎖にフッ素含有アルキル基を導入した単位を有するポリマーをベース樹脂として使用することにより、高透明性を損なうことなく、高コントラストで密着性にも優れたレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料が得られることを知見し、本発明に至ったものである。

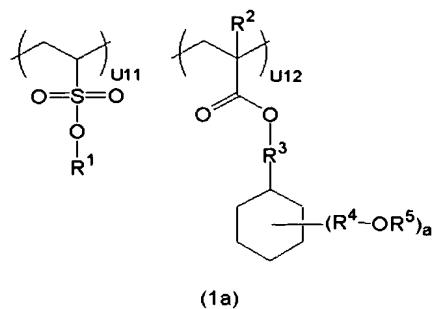
【0012】

即ち、本発明は下記の高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法を提供する。

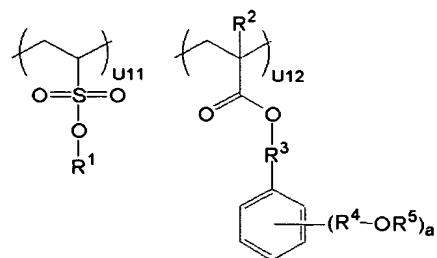
請求項1：

下記一般式 (1a) 又は (1b) で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

【化8】



(1a)



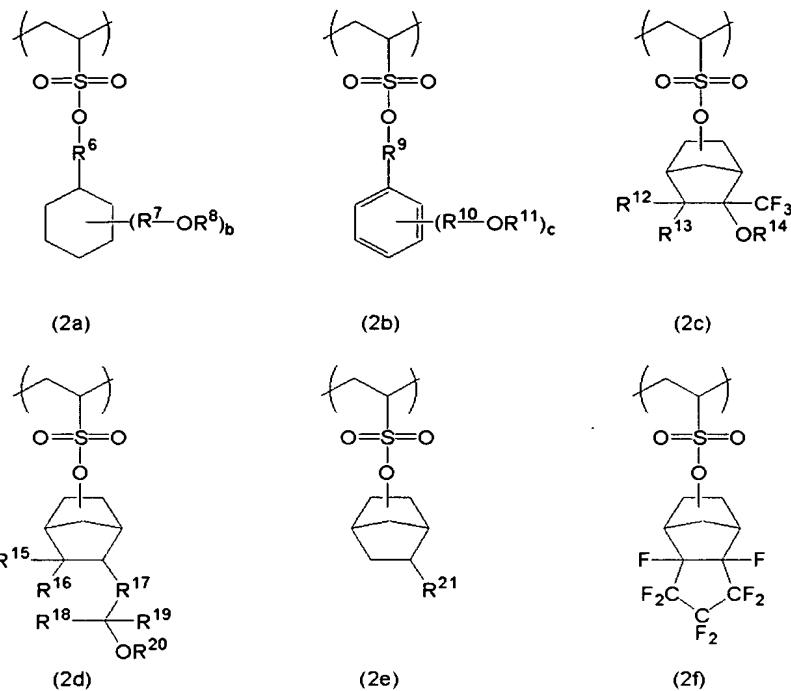
(1b)

(式中、 R^1 は酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい
炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基であ
る。 R^2 は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしく
は環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 R^3 及び R^4 は単結合
、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素
化されたアルキレン基である。 R^5 は水素原子又は酸不安定基である。 a は1又
は2である。 $0 < \text{U}_{11} < 1$ 、 $0 < \text{U}_{12} < 1$ である。)

請求項2：

上記一般式(1a)及び(1b)中のスルホン酸エステルユニットが下記一般
式(2a)～(2f)から選ばれるものであることを特徴とする請求項1記載の
高分子化合物。

【化9】

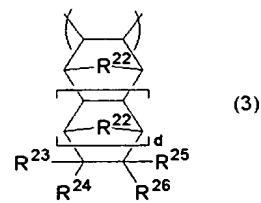


(式中、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰及びR¹⁷は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R⁸、R¹¹、R¹⁴及びR²⁰は水素原子又は酸不安定基である。R¹²、R¹³、R¹⁵、R¹⁶、R¹⁸、R¹⁹は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹⁸又はR¹⁹の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。R²¹は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。b及びcはそれぞれ1又は2である。)

請求項3：

下記一般式(3)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の高分子化合物。

【化10】

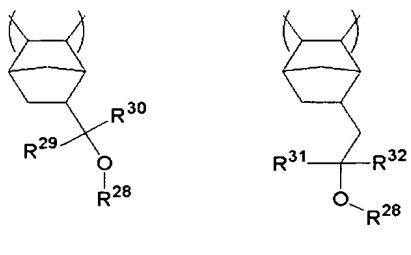


(式中、R²²はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R²³～R²⁶は、水素原子、フッ素原子、-R²⁷-OR²⁸、-R²⁷-CO₂R²⁸又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R²³～R²⁶のうち少なくとも一つは、-R²⁷-OR²⁸又は-R²⁷-CO₂R²⁸を含む。R²⁷は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R²⁸は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。dは0又は1である。)

請求項4：

上記一般式(3)で表される繰り返し単位が下式(3a)又は(3b)で表される構造であることを特徴とする請求項3記載の高分子化合物。

【化11】

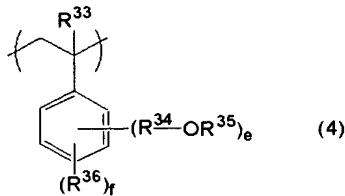


(式中、R²⁸は上記と同様である。R²⁹～R³²はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R²⁹及びR³⁰の少なくともどちらか一方、R³¹及びR³²の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

請求項5：

更に、下記一般式(4)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の高分子化合物。

【化 1 2】

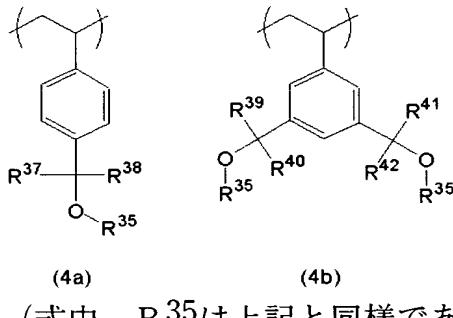


(式中、R³³は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R³⁴は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R³⁵は水素原子又は酸不安定基である。R³⁶はフッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。eは1又は2、fは0～4の整数であり、 $1 \leq e + f \leq 5$ である。)

請求項 6 :

上記一般式(4)で表される繰り返し単位が下式(4a)又は(4b)で表されることを特徴とする請求項5記載の高分子化合物。

【化 1 3】



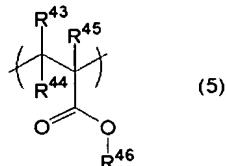
(式中、R35は上記と同様である。R37～R42はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R37及びR38の少なくともどちらか一方、R39及びR40の少なくともどちらか一方、R41及びR42の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

請求項 7：

更に、下記一般式（5）で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の高分子化合物。



【化14】



(式中、R⁴³～R⁴⁵は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R⁴⁶は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。)

請求項8：

上記一般式(5)におけるR⁴⁵がトリフルオロメチル基であることを特徴とする請求項7記載の高分子化合物。

請求項9：

請求項1乃至8のいずれか1項に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

請求項10：

- (A) 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の高分子化合物、
- (B) 有機溶剤、
- (C) 酸発生剤

を含有することを特徴とする化学增幅ポジ型レジスト材料。

請求項11：

更に塩基性化合物を含有する請求項10記載のレジスト材料。

請求項12：

更に溶解阻止剤を含有する請求項10又は11記載のレジスト材料。

請求項13：

- (1) 請求項9乃至12のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、
- (2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100～180nm帯又は1～30nm帯の高エネルギー線で露光する工程と、
- (3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むこと

を特徴とするパターン形成方法。

請求項14：

前記高エネルギー線がF₂レーザー、Ar₂レーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項13記載のパターン形成方法。

【0013】

以下、本発明について更に詳しく説明する。

本発明者の検討によれば、157nm付近の透過率を向上させる方法としては、カルボニル基や炭素-炭素間二重結合の数の低減化も一つの方法と考えられるが、ベースポリマー中へのフッ素原子の導入も透過率向上に大きく寄与することがわかつってきた。実際、ポリビニルフェノールの芳香環にフッ素を導入したポリマーは透過率の向上が確認できた（特開2001-146505号公報）。しかしながら、このベースポリマーはF₂レーザーのような高エネルギー光の照射によりネガ化が進行することが顕著になり、レジストとしての実用化は難しいことが判明した。

【0014】

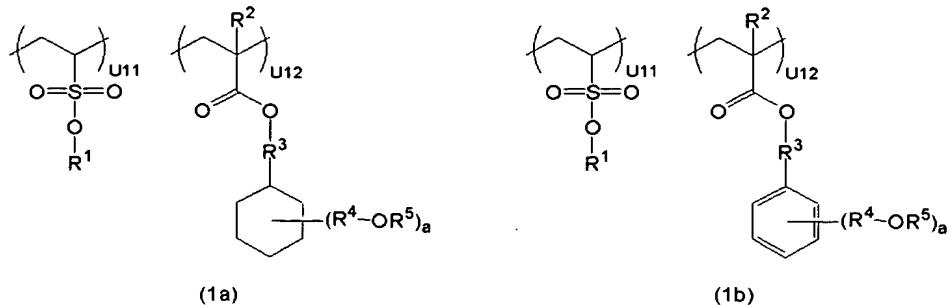
これに対し、アクリル系樹脂やノルボルネン誘導体由来の脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物にフッ素を導入したポリマーは、透明度も高く、ネガ化も起こらないことが判明した。しかし、樹脂の透明性を高めるためにフッ素の導入率を上げると、樹脂の基板密着性や現像液の浸透性が悪くなる傾向にある。本発明では157nm付近の透過率が比較的高く、基板密着性や現像液浸透性に優れるスルホン酸エステル類を高透明な含フッ素アクリルポリマー中に導入することにより、透明性を損なうことなく上記の欠陥を改善することができた。

【0015】

特に本発明では下記一般式（1a）又は（1b）で表されるユニットを樹脂中に導入することにより、157nmにおける透明性を確保しつつ基板密着性や現像液浸透性に優れるレジスト材料が得られたものである。

【0016】

【化 1 5】

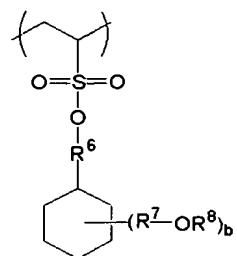


(式中、R¹は酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。R²は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R³及びR⁴は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R⁵は水素原子又は酸不安定基である。aは1又は2である。0 < U₁₁ < 1、0 < U₁₂ < 1である。)

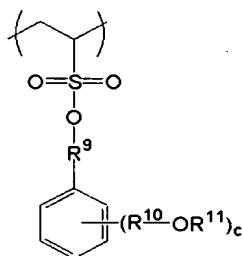
【0017】

この場合、上記一般式（1 a）及び（1 b）中のスルホン酸エステルユニットは、下記一般式（2 a）～（2 f）から選ばれるものであることが好ましい。

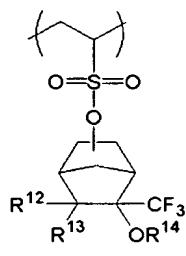
【化16】



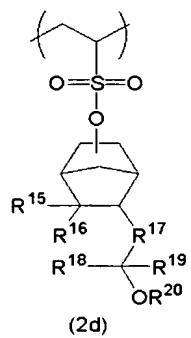
(2a)



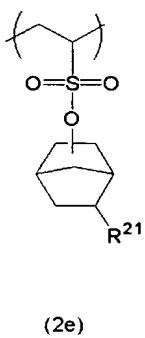
(2b)



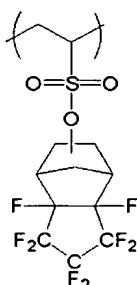
(2c)



(2d)



(2e)



(2f)

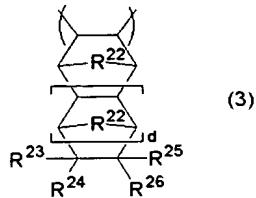
(式中、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰及びR¹⁷は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R⁸、R¹¹、R¹⁴及びR²⁰は水素原子又は酸不安定基である。R¹²、R¹³、R¹⁵、R¹⁶、R¹⁸、R¹⁹は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R¹⁸又はR¹⁹の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。R²¹は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。b及びcはそれぞれ1又は2である。)

【0018】

本発明の高分子化合物は、上記一般式(1a)又は(1b)で示される繰り返し単位を有するものであるが、これに加えてレジストの溶解コントラスト、基板密着性、ドライエッチング耐性などの性能を向上させる目的で下記一般式(3)で表される繰り返し単位、及び/又は下記一般式(4)で表される繰り返し単位、及び/又は下記一般式(5)で表される繰り返し単位を有することが好ましい。

【0019】

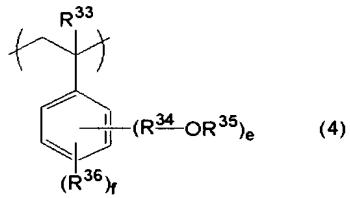
【化17】



(式中、R22はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R23～R26は、水素原子、フッ素原子、 $-R^{27}-OR^{28}$ 、 $-R^{27}-CO_2R^{28}$ 又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R23～R26のうち少なくとも一つは、 $-R^{27}-OR^{28}$ 又は $-R^{27}-CO_2R^2$ 8を含む。R27は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R28は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。dは0又は1である。)

【0020】

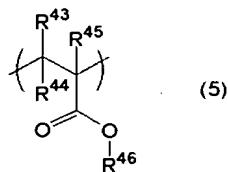
【化18】



(式中、R33は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R34は単結合、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R35は水素原子又は酸不安定基である。R36はフッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。eは1又は2、fは0～4の整数であり、 $1 \leq e + f \leq 5$ である。)

【0021】

【化19】

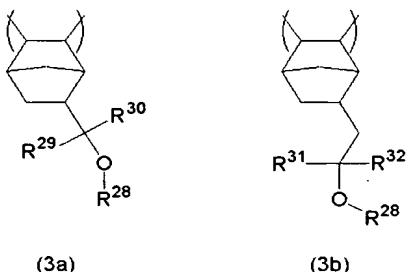


(式中、R⁴³～R⁴⁵は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R⁴⁶は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。この場合、R⁴⁵としてはトリフルオロメチル基であることが好ましい。)

【0022】

なお、上記一般式(3)で表される繰り返し単位としては、下記式(3a)又は(3b)で表される繰り返し単位であることが好ましい。

【化20】

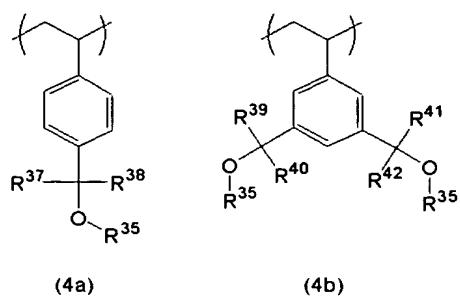


(式中、R²⁸は上記と同様である。R²⁹～R³²はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R²⁹及びR³⁰の少なくともどちらか一方、R³¹及びR³²の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

【0023】

また、上記一般式(4)で表される繰り返し単位としては、下記式(4a)又は(4b)で表される繰り返し単位であることが好ましい。

【化 2 1】



(式中、R35は上記と同様である。R37～R42はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R37及びR38の少なくともどちらか一方、R39及びR40の少なくともどちらか一方、R41及びR42の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

[0 0 2 4]

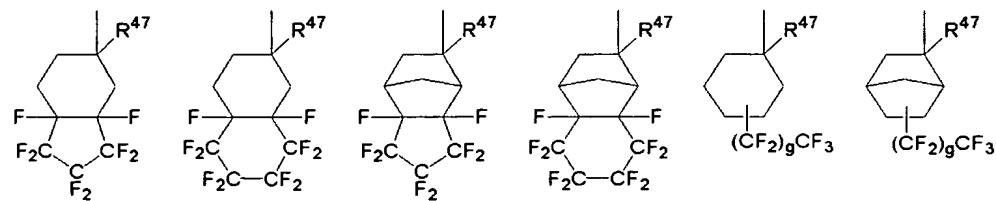
この場合、炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基、2-アダマンチル基、(2-アダマンチル)メチル基等が例示でき、特に炭素数1～12、とりわけ炭素数1～10のものが好ましい。

〔0025〕

フッ素化されたアルキル基は、上記アルキル基の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたものであり、トリフルオロメチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、3, 3, 3-トリフルオロプロピル基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロイソプロピル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロピル基等が挙げられるほか、下記式で表されるような基も用いられる。

【0 0 2 6】

【化 2 2】



(式中、R⁴⁷は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。gは0～5の整数である。)

【0027】

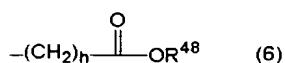
炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基としては、上記アルキル基中の一個の水素を脱離した形式のものが用いられ、フッ素化されたアルキレン基はそれらの一部又は全部がフッ素原子で置換されたものが用いられる。

【0028】

次にR¹、R⁵、R⁸、R¹¹、R¹⁴、R²⁰、R²⁸、R³⁵及びR⁴⁶で表される酸不安定基について説明する。酸不安定基としては種々選定されるが、特に下記一般式(6)～(8)で示される基等であることが好ましい。

【0029】

【化23】



【0030】

上記式(6)において、R⁴⁸は炭素数4～20、好ましくは4～15の三級アルキル基、又は炭素数4～20のオキソアルキル基を示し、三級アルキル基として具体的には、tert-ブチル基、tert-アミル基、1,1-ジエチルプロピル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロヘキセニル基、2-メチル-2-アダマンチル基等が挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、3-オキソシクロヘキシル基、4-メチル-2-オキソオキサン-4-イル基、5-メチル-5-

オキソオキソラン-4-イル基等が挙げられる。hは0～6の整数である。

【0031】

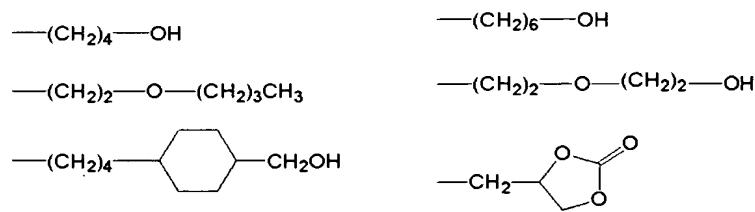
上記式(6)の酸不安定基としては、具体的にはtert-ブロキシカルボニル基、tert-ブロキシカルボニルメチル基、tert-アミロキシカルボニル基、tert-アミロキシカルボニルメチル基、1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1-エチルシクロヘキサメチル基、1-エチルシクロヘキサメチル基、1-エチル-2-シクロヘキサメチル基、1-エチル-2-シクロヘキサメチル基、1-エチル-2-シクロヘキサメチル基、2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

【0032】

上記式(7)において、R⁴⁹及びR⁵⁰は水素原子又は炭素数1～18、好ましくは1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキサメチル基、シクロヘキサメチル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R⁵¹は炭素数1～18、好ましくは1～10の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

【0033】

【化24】



【0034】

R⁴⁹とR⁵⁰、R⁴⁹とR⁵¹、R⁵⁰とR⁵¹とは互いに結合して環を形成してもよく

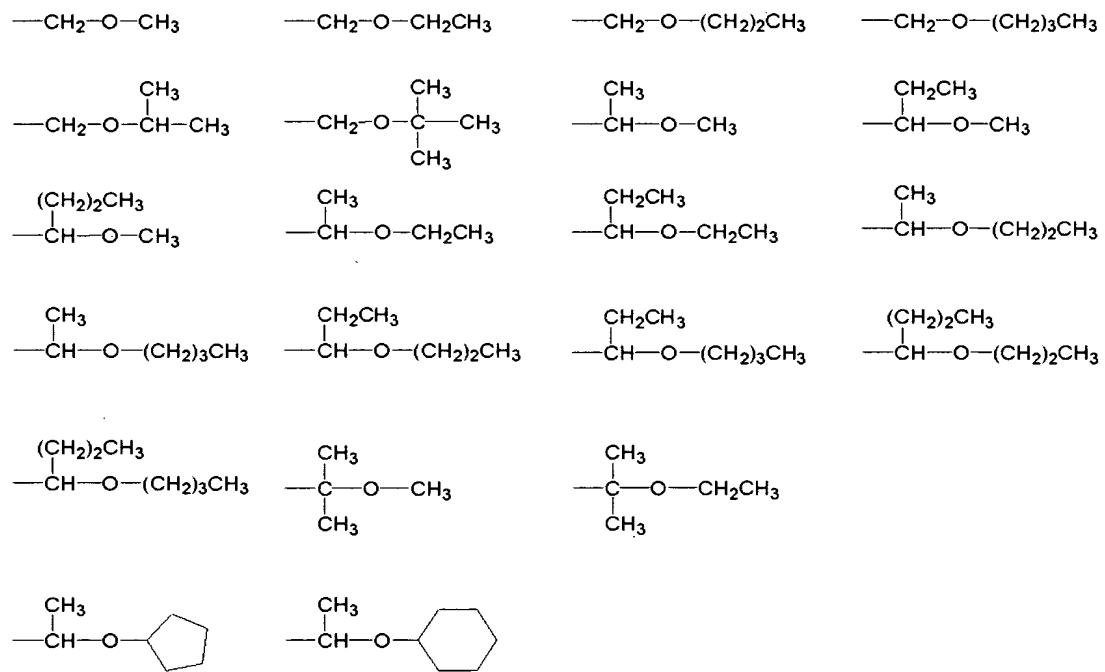
、環を形成する場合にはR⁴⁹、R⁵⁰及びR⁵¹はそれぞれ炭素数1～18、好ましくは1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0035】

上記式(7)で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の基が例示できる。

【0036】

【化25】



【0037】

上記式(7)で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。式(7)としては、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エトキシプロピル基が好ましい。

【0038】

上記式(8)においてR⁵²、R⁵³及びR⁵⁴は炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基等の1価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、R⁵²とR⁵³、R⁵²とR⁵⁴、R⁵³とR⁵⁴とは

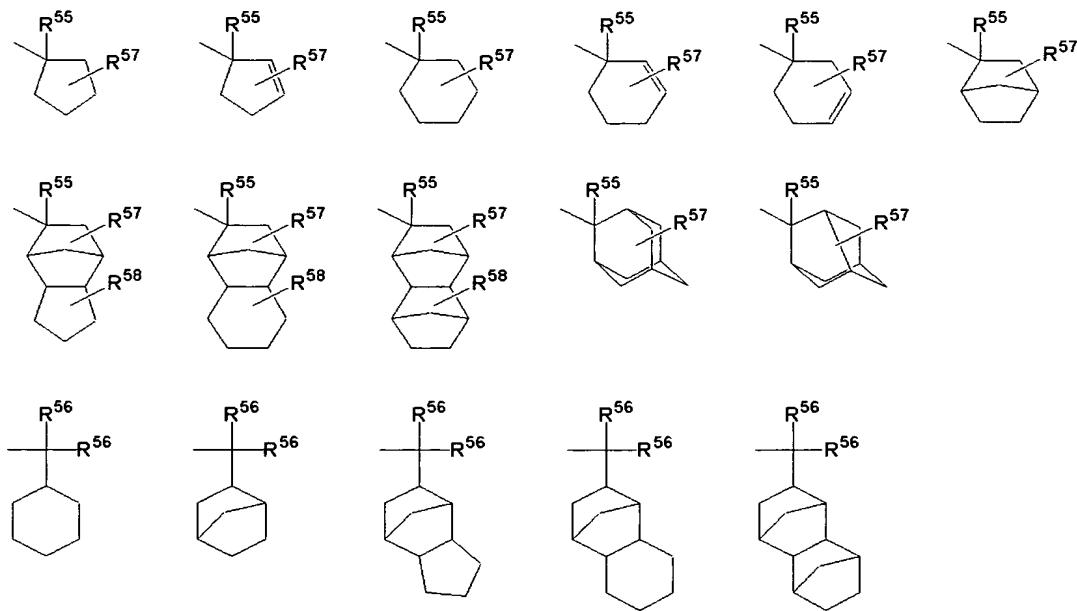
互いに結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成してもよい。

【0039】

上記式（8）に示される三級アルキル基としては、*tert*-ブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボルニル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、*tert*-アミル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-メチル-1-イソプロピル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-シクロヘキシル-1-イソプロピル基等を挙げることができるほか、下記に示す基を具体的に挙げることができる。

【0040】

【化26】



【0041】

ここで、R⁵⁵は炭素数1～6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。R⁵⁶は炭素数2～6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*

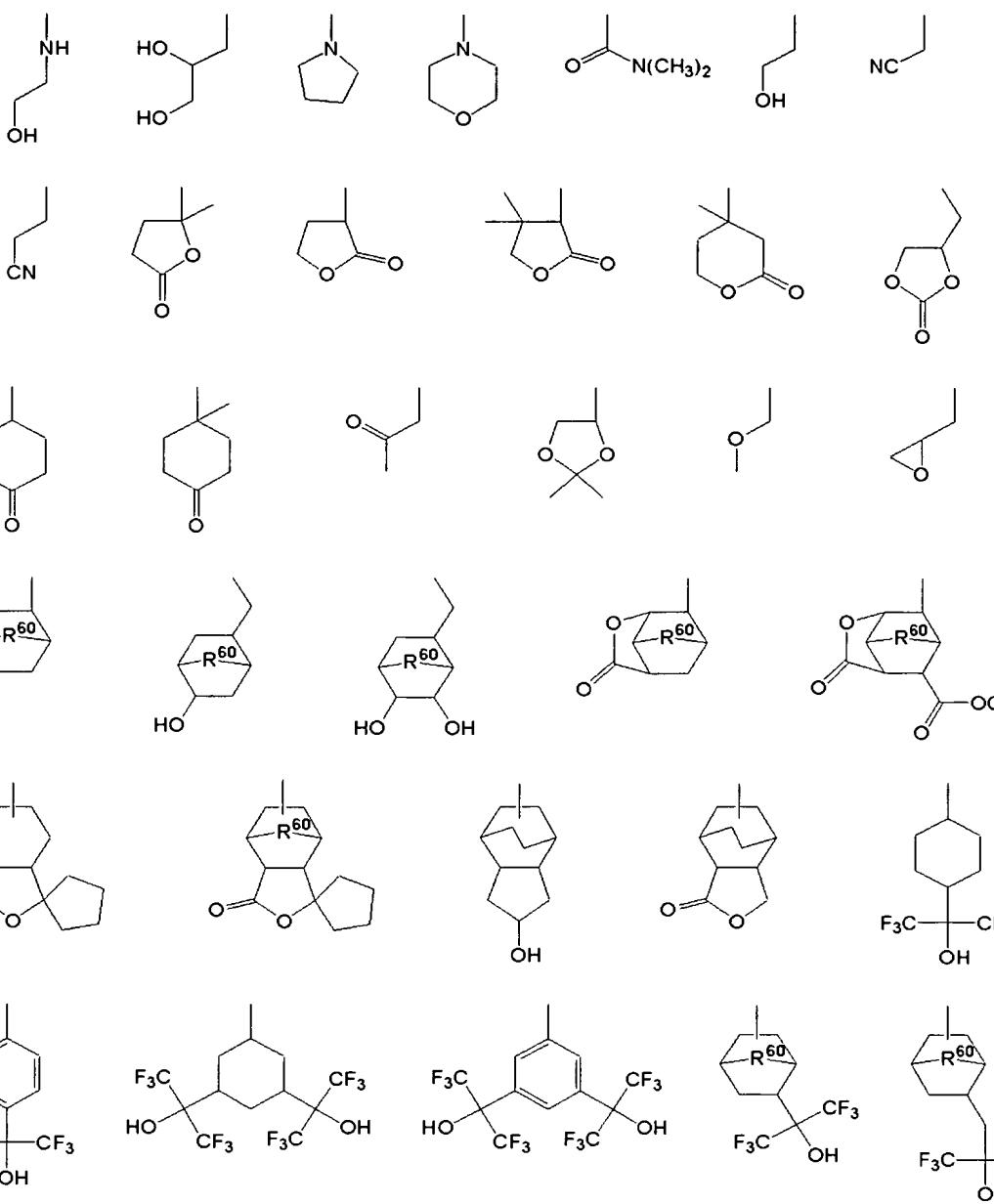
一ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。R⁵⁷及びR⁵⁸は水素原子、炭素数1～6のヘテロ原子を含んでもよい1価炭化水素基、又は炭素数1～6のヘテロ原子を介してもよい1価炭化水素基を示し、これらは直鎖状、分岐状、環状のいずれでもよい。この場合ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子を挙げることができ、-OH、-OR⁵⁹、-O-、-S-、-S(=O)-、-NH₂、-NHR⁵⁹、-N(R⁵⁹)₂、-NH-、-NR⁵⁹-として含有又は介在することができる。R⁵⁹は炭素数1～5のアルキル基を示す。R⁵⁷及びR⁵⁸としては、具体的には、メチル基、ヒドロキシメチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基、プロピル基イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、メトキシ基、メトキシメトキシ基、エトキシ基、tert-ブトキシ基等を例示できる。

【0042】

次に、R¹、R²⁸、及びR⁴⁶で表される密着性基について説明する。密着性基としては種々選定されるが、特に下記一般式で示される基等であることが好ましい。

【0043】

【化 2 7】



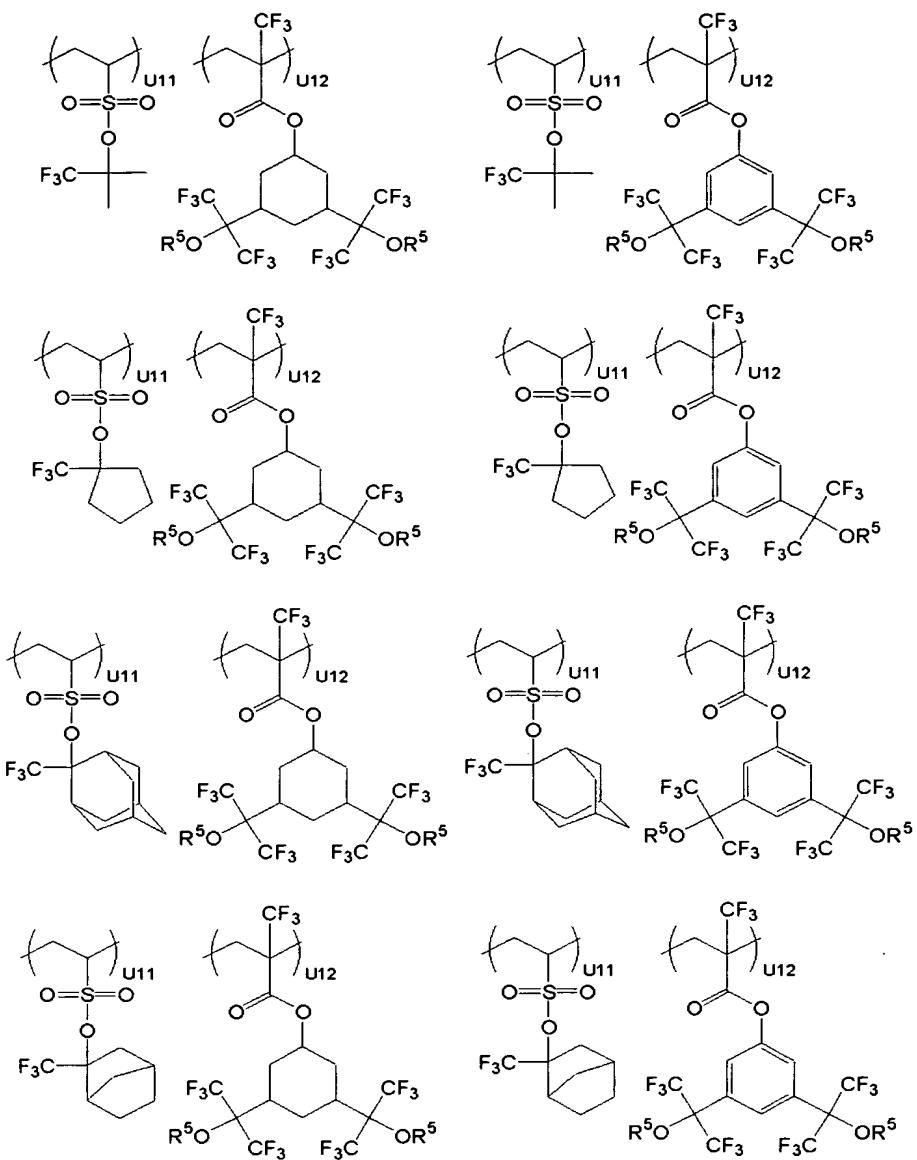
(式中、R⁶⁰はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。)

【0 0 4 4】

ここで、一般式 (1 a) 及び (1 b) で表されるポリマーの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

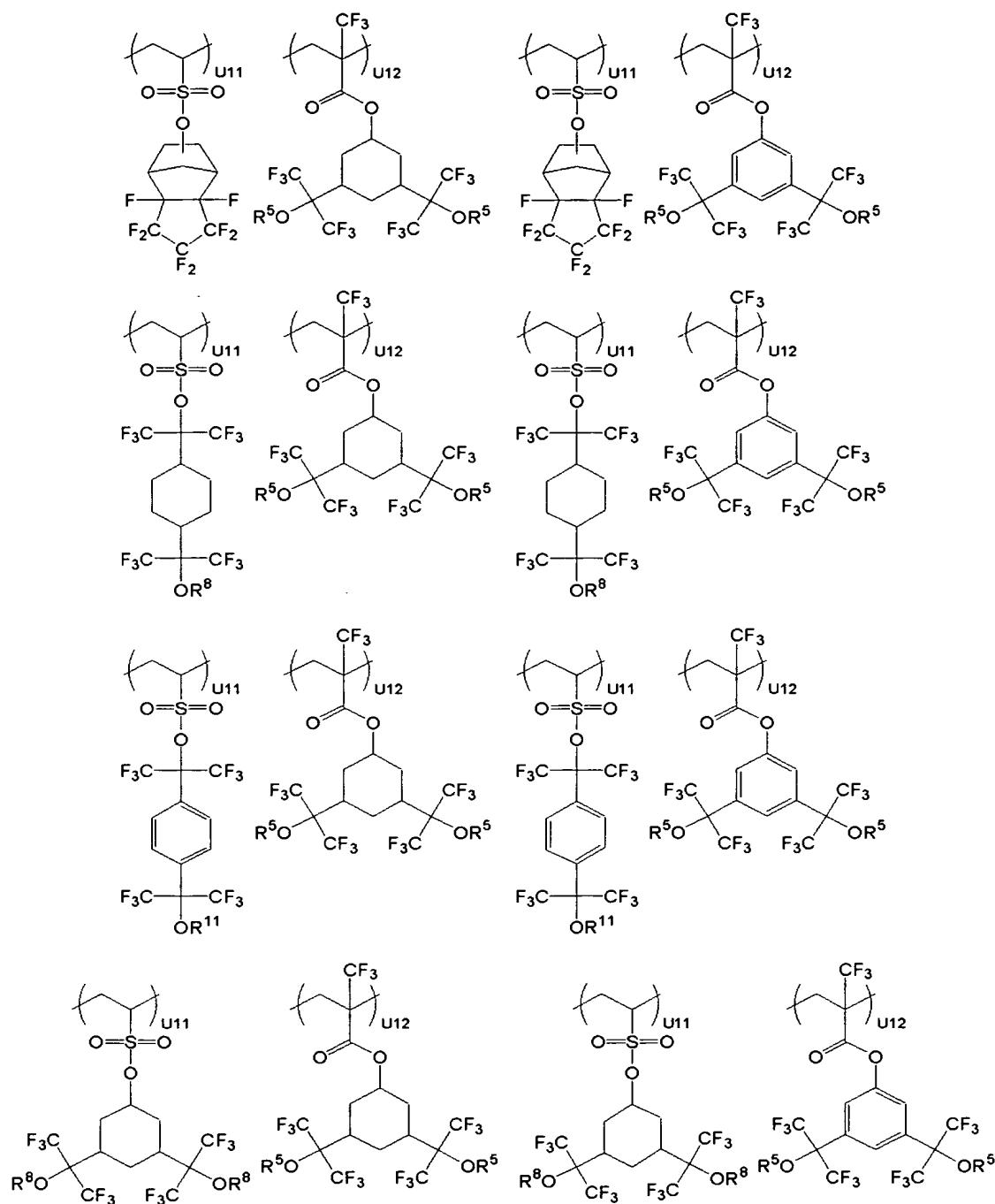
【0 0 4 5】

【化 28】



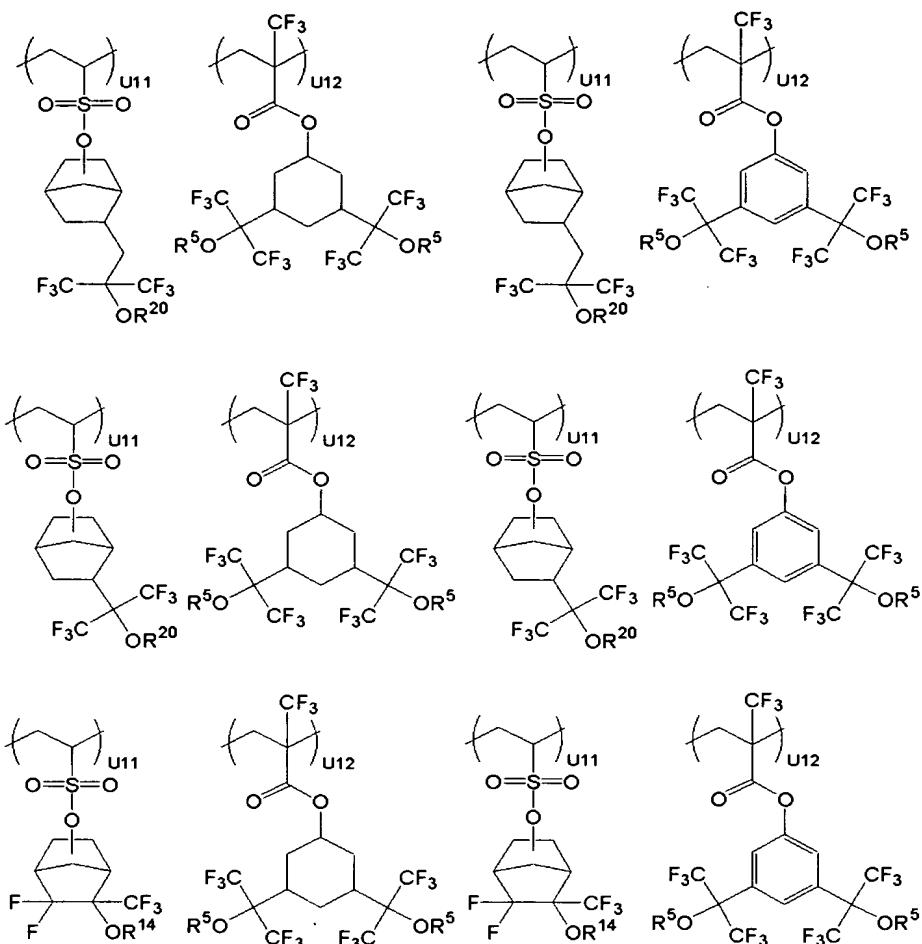
【0046】

【化29】



【0047】

【化 30】



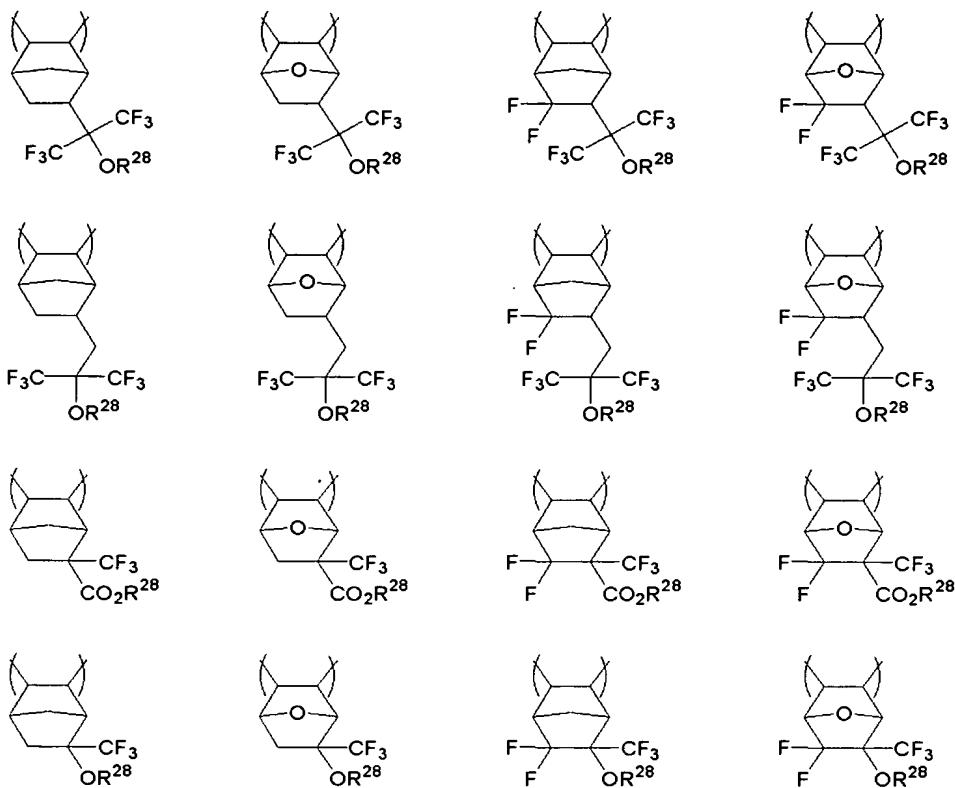
(式中、R⁵、R⁸、R¹¹、R²⁰、U¹¹及びU¹²は上記と同様である。)

【0048】

一般式(3)、(3a)、及び(3b)で表されるユニットの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0049】

【化31】



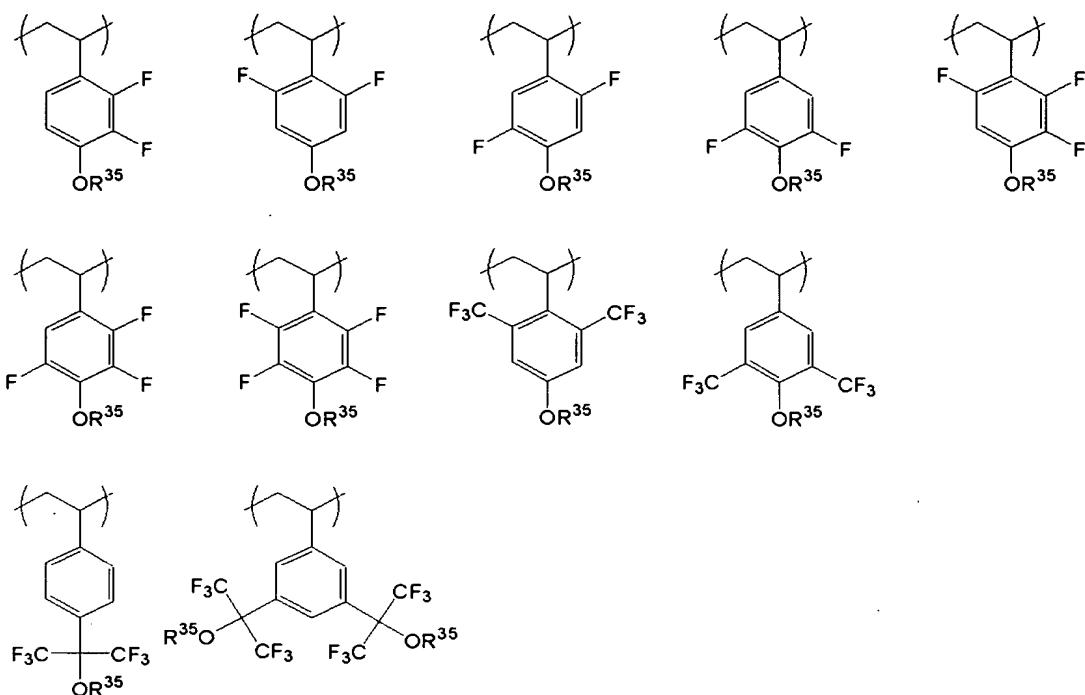
(式中、R²⁸は上記と同様である。)

【0050】

一般式(4)、(4a)、及び(4b)で表されるユニットの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0051】

【化32】



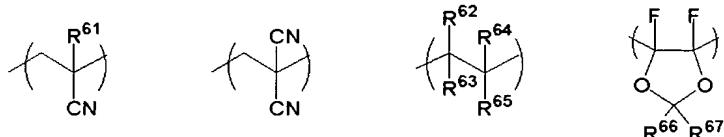
(式中、R³⁵は上記と同様である。)

【0052】

本発明で用いられる高分子化合物は、樹脂の基板密着性や透明性を向上させる点から下記のような単位を導入することができる。

【0053】

【化33】



(式中、R⁶¹～R⁶⁵は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1～4のフッ素化されたアルキル基であり、R⁶¹～R⁶⁵のうち少なくとも1個以上のフッ素原子を含む。R⁶⁶及びR⁶⁷は水素原子、メチル基、又はトリフルオロメチル基である。)

【0054】

本発明の高分子化合物において、一般式(3)、(3a)及び(3c)のユニットをU3、一般式(4)、(4a)及び(4c)で表されるユニットをU4、一般式(5)のユニットをU5、上記以外の密着性及び透明性ユニットの単位を

U 6 とする場合、 $U_{11} + U_{12} + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 = 1$ であり、

$0 < U_{11} \leq 0.9$ 、より好ましくは、 $0.1 \leq U_{11} \leq 0.5$

$0 < U_{12} \leq 0.9$ 、より好ましくは、 $0.1 \leq U_{12} \leq 0.5$

$0 \leq U_3 \leq 0.6$ 、より好ましくは、 $0 \leq U_3 \leq 0.4$

$0 \leq U_4 \leq 0.6$ 、より好ましくは、 $0 \leq U_4 \leq 0.4$

$0 \leq U_5 \leq 0.7$ 、より好ましくは、 $0 \leq U_5 \leq 0.5$

$0 \leq U_6 \leq 0.4$ 、より好ましくは、 $0 \leq U_6 \leq 0.2$

であることが好ましい。

【0055】

本発明の高分子化合物を合成する場合、上記式 (1 a) 、 (1 b) 、 (2 a) ~ (2 f) 、 (3) 、 (3 a) 、 (3 c) 、 (4) 、 (4 a) 、 (4 c) 、及び (5) に対応するモノマー及び密着性向上モノマー、透明性向上モノマー等を溶媒に溶解させ、触媒を添加して、場合によっては加熱又は冷却しながら重合反応を行う。重合反応は開始剤（又は触媒）の種類、開始の方法（光、熱、放射線、プラズマ等）、重合条件（温度、圧力、濃度、溶媒、添加物）等によっても支配される。本発明の高分子化合物の重合においては、2, 2' -アゾビスイソブチロニトリル（以下、AIBNと略記）等のラジカルによって重合が開始されるラジカル共重合、アルキルリチウム等の触媒を用いたイオン重合（アニオン重合）等が一般的である。これらの重合はその常法に従って行うことができる。

【0056】

ラジカル重合開始剤としては特に限定されるものではないが、例としてAIBN、2, 2' -アゾビス（4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル）、2, 2' -アゾビス（2, 4-ジメチルバレロニトリル）、2, 2' -アゾビス（2, 4, 4-トリメチルペンタン）等のアゾ系化合物、tert-ブチルパーオキシピバレート、ラウロイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、tert-ブチルパーオキシラウレート等の過酸化物系化合物、また水溶性開始剤としては過硫酸カリウムのような過硫酸塩、更には過硫酸カリウムや過酸化水素等の過酸化物と亜硫酸ナトリウムのような還元剤の組み合わせからなるレドックス系開始剤が例示される。重合開始剤の使用量は、種類、重合反応条件等に応じ

て適宜変更可能であるが、通常は重合させるべき単量体全量に対して0.001～5重量%、特に0.01～2重量%が採用される。

【0057】

また、重合反応においては重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸n-ブチル等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、トルエン、キシレン、シクロヘキサン等の脂肪族又は芳香族炭化水素類、イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独でもあるいは2種類以上を混合しても使用できる。またドデシルメルカプタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよい。

【0058】

重合反応の反応温度は重合開始剤の種類あるいは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は20～200℃が好ましく、特に50～140℃が好ましい。かかる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

【0059】

このようにして得られる本発明にかかる重合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用できるが、例を挙げれば再沈澱濾過又は減圧下での加熱留出等の方法がある。

【0060】

上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000～500,000、特に2,000～100,000とすることが望ましい。

【0061】

なお、本発明の高分子化合物は、レジスト材料、特に化学增幅型、とりわけ化学增幅ポジ型レジスト材料のベース樹脂として使用することができるが、膜の力学物性、熱的物性、アルカリ可溶性、その他の物性を変える目的で他の高分子化合物を混合することもできる。その際、混合する高分子化合物の範囲は特に限定されないが、レジスト用の公知の高分子化合物等と任意の範囲で混合することが

できる。

【0062】

本発明のレジスト材料は、本発明の高分子化合物をベース樹脂とする以外は公知の成分を用いて調製し得るが、特に化学増幅ポジ型レジスト材料は、

(A) 上記高分子化合物（ベース樹脂）、

(B) 有機溶剤、

(C) 酸発生剤

を含有する。この場合、これら成分に、更に

(D) 塩基性化合物、

(E) 溶解阻止剤

を配合してもよい。

【0063】

本発明で使用される（B）成分の有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。このような有機溶剤としては、例えば、シクロヘキサン、メチル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレンジリコールモノメチルエーテル、エチレンジリコールモノメチルエーテル、プロピレンジリコールモノメチルエーテル、エチレンジリコールモノエチルエーテル、プロピレンジリコールジメチルエーテル、ジエチレンジリコールジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレンジリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレンジリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert-ブチル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレンジリコールモノtert-ブチルエーテルアセテート等のエステル類、 γ -ブチルラクトン等のラクトン類が挙げられる。

【0064】

また、フッ素化された有機溶剤も用いることができる。具体的に例示すると、2-フルオロアニソール、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソール、

2, 3-ジフルオロアニソール、2, 4-ジフルオロアニソール、2, 5-ジフルオロアニソール、5, 8-ジフルオロ-1, 4-ベンゾジオキサン、2, 3-ジフルオロベンジルアルコール、1, 3-ジフルオロ-2-プロパノール、2', 4'-ジフルオロプロピオフェノン、2, 4-ジフルオロトルエン、トリフルオロアセトアルデヒドエチルヘミアセタール、トリフルオロアセトアミド、トリフルオロエタノール、2, 2, 2-トリフルオロブチレート、エチルヘプタフルオロエタノール、エチルヘプタフルオロブチルアセテート、エチルヘキサフルオログルタリルメチル、エチル-3-ヒドロキシ-4, 4, 4-トリフルオロアセトアセテート、エチルペンタフルオロプロピニルアセテート、エチルパフルオロオクタノエート、エチル-4, 4, 4-トリフルオロアセトアセテート、エチル-4, 4, 4-トリフルオロクロトネート、エチルトリフルオロピルベート、sec-エチルトリフルオロアセテート、フルオロシクロヘキサン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-ブタノール、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロ-7, 7-ジメチル-4, 6-オクタンジオン、1, 1, 1, 3, 5, 5, 5-ヘプタフルオロペンタン-2, 4-ジオン、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-ペンタノール、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-ペンタノン、イソプロピル-4, 4, 4-トリフルオロアセトアセテート、メチルパフルオロデナノエート、メチルパフルオロ(2-メチル-3-オキサヘキサノエート)、メチルパフルオロノナノエート、メチルパフルオロオクタノエート、メチル-2, 3, 3-テトラフルオロプロピオネート、メチルトリフルオロアセトアセテート、1, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 6-オクタフルオロ-2, 4-ヘキサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-1-ペンタノール、1H, 1H, 2H, 2H-パフルオロ-1-デカノール、パフルオロ(2, 5-ジメチル-3, 6-ジオキサンアニオニック)酸メチルエステル、2H-パフルオロ-5-メチル-3, 6-ジオキサンナン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パフルオロノナン-1, 2-ジオール、1H, 1H, 9H-パフルオロ-1-ノナノール、1H, 1H-パフルオロオクタノール、1H, 1H, 2H, 2H-パフルオロオクタノール、2H-パフルオ

ロ-5, 8, 11, 14-テトラメチル-3, 6, 9, 12, 15-ペンタオキサオクタデカン、パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミン、パーフルオロ-2, 5, 8-トリメチル-3, 6, 9, 12, 15-ペンタオキサオクタデカン、パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミン、パーフルオロ-2, 5, 8-トリメチル-3, 6, 9-トリオキサドデカン酸メチルエステル、パーフルオロトリペンチルアミン、パーフルオロトリイソプロピルアミン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロウンデカン-1, 2-ジオール、トリフルオロブタノール、1, 1, 1-トリフルオロ-5-メチル-2, 4-ヘキサンジオン、1, 1, 1-トリフルオロ-2-プロパノール、3, 3, 3-トリフルオロ-1-プロパノール、1, 1, 1-トリフルオロ-2-プロピルアセテート、パーフルオロブチルテトラヒドロフラン、パーフルオロデカリン、パーフルオロ(1, 2-ジメチルシクロヘキサン)、パーフルオロ(1, 3-ジメチルシクロヘキサン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルトリフルオロメチルアセテート、トリフルオロメチル酢酸ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオン酸メチル、パーフルオロシクロヘキサン、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸ブチル、1, 1, 1-トリフルオロ-5, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサンジオン等が例示できる。

【0065】

これらの溶媒は1種を単独で又は2種以上を混合して使用することもできるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシ-2-プロパノールのほか、安全溶剤であるプロピレングリコールモノメチルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される。

【0066】

上記溶剤の使用量は、ベース樹脂100部(重量部、以下同じ)に対し300～10,000部、特に500～5,000部が好ましい。

【0067】

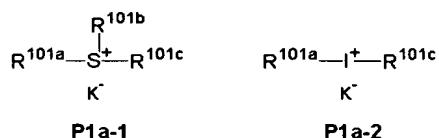
(C) 成分の酸発生剤としては、

- i. 下記一般式 (P 1 a - 1) 、 (P 1 a - 2) 又は (P 1 b) のオニウム塩、
- i i. 下記一般式 (P 2) のジアゾメタン誘導体、
- i i i. 下記一般式 (P 3) のグリオキシム誘導体、
- i v. 下記一般式 (P 4) のビススルホン誘導体、
- v. 下記一般式 (P 5) のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル、
- v i. β -ケトスルホン酸誘導体、
- v i i. ジスルホン誘導体、
- v i i i. ニトロベンジルスルホネート誘導体、
- i x. スルホン酸エステル誘導体

等が挙げられる。

【0068】

【化34】



(式中、 R^{101a} 、 R^{101b} 、 R^{101c} はそれぞれ炭素数 1 ~ 12 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキソアルケニル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基、又は炭素数 7 ~ 12 のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、 R^{101b} と R^{101c} とは環を形成してもよく、環を形成する場合には、 R^{101b} 、 R^{101c} はそれぞれ炭素数 1 ~ 6 のアルキレン基を示す。 K^- は非求核性対向イオンを表す。)

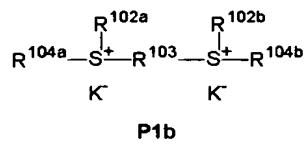
【0069】

上記 R^{101a} 、 R^{101b} 、 R^{101c} は互いに同一であっても異なっていてもよく、具体的にはアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル

基としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、2-オキソシクロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基等が挙げられ、2-オキソプロピル基、2-シクロペンチル-2-オキソエチル基、2-シクロヘキシル-2-オキソエチル基、2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-オキソエチル基等を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等や、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基、メチルナフチル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、メトキシナフチル基、エトキシナフチル基等のアルコキシナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエチルナフチル基等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェニルエチル基、フェネチル基等が挙げられる。アリールオキソアルキル基としては、2-フェニル-2-オキソエチル基、2-(1-ナフチル)-2-オキソエチル基、2-(2-ナフチル)-2-オキソエチル基等の2-アリール-2-オキソエチル基等が挙げられる。K⁻の非求核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1, 1, 1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネート、1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられる。

【0070】

【化35】



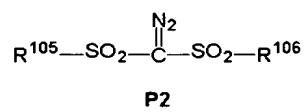
(式中、R^{102a}、R^{102b}はそれぞれ炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R¹⁰³は炭素数1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示す。R^{104a}、R^{104b}はそれぞれ炭素数3～7の2-オキソアルキル基を示す。K⁻は非求核性対向イオンを表す。)

【0071】

上記R^{102a}、R^{102b}として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基等が挙げられる。R¹⁰³としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、1,2-シクロヘキシレン基、1,3-シクロペンチレン基、1,4-シクロオクチレン基、1,4-シクロヘキサンジメチレン基等が挙げられる。R^{104a}、R^{104b}としては、2-オキソプロピル基、2-オキソシクロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基、2-オキソシクロヘプチル基等が挙げられる。K⁻は式(P1a-1)及び(P1a-2)で説明したものと同様のものを挙げることができる。

【0072】

【化36】



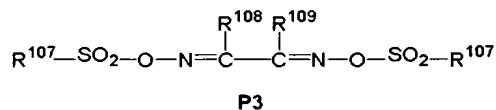
(式中、R¹⁰⁵、R¹⁰⁶は炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数6～20のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数7～12のアラルキル基を示す。)

【0073】

R 105、R 106のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル基、1, 1, 1-トリフルオロエチル基、1, 1, 1-トリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-tert-ブキシフェニル基、m-tert-ブキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化アリール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル基、1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

【0074】

【化37】



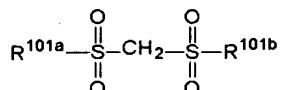
(式中、R 107、R 108、R 109は炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数6～20のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数7～12のアラルキル基を示す。R 108、R 109は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、R 108、R 109はそれぞれ炭素数1～6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

【0075】

R 107、R 108、R 109のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R 105、R 106で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R 108、R 109のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0076】

【化38】

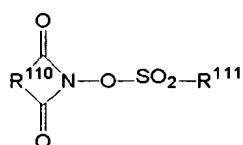


P4

(式中、R^{101a}、R^{101b}は上記と同様である。)

【0077】

【化39】



P5

(式中、R¹¹⁰は炭素数6～10のアリーレン基、炭素数1～6のアルキレン基又は炭素数2～6のアルケニレン基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、ニトロ基、アセチル基、又はフェニル基で置換されていてもよい。R¹¹¹は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は置換のアルキル基、アルケニル基又はアルコキシアルキル基、フェニル基、又はナフチル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1～4のアルキル基又はアルコキシ基；炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基；炭素数3～5のヘテロ芳香族基；又は塩素原子、フッ素原子で置換されていてもよい。)

【0078】

ここで、R¹¹⁰のアリーレン基としては、1, 2-フェニレン基、1, 8-ナフチレン基等が、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、フェニルエチレン基、ノルボルナン-2, 3-ジイル基等が、アルケニレン基としては、1, 2-ビニレン基、1-フェニル-1, 2-ビニレン基、5-ノルボルネン-2, 3-ジイル基等が挙げられる。R¹¹¹のアルキル基としては、R^{101a}～R^{101c}と同様のものが、アルケニル基としては、

ビニル基、1-プロペニル基、アリル基、1-ブテニル基、3-ブテニル基、イソブレニル基、1-ペンテニル基、3-ペンテニル基、4-ペンテニル基、ジメチルアリル基、1-ヘキセニル基、3-ヘキセニル基、5-ヘキセニル基、1-ヘプテニル基、3-ヘプテニル基、6-ヘプテニル基、7-オクテニル基等が、アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、ブトキシメチル基、ペンチロキシメチル基、ヘキシロキシメチル基、ヘプチロキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブトキシエチル基、ペンチロキシエチル基、ヘキシロキシエチル基、メトキシプロピル基、エトキシプロピル基、プロポキシプロピル基、ブトキシプロピル基、メトキシブチル基、エトキシブチル基、プロポキシブチル基、メトキシペンチル基、エトキシペンチル基、メトキシヘキシル基、メトキシヘプチル基等が挙げられる。

【0079】

なお、更に置換されていてもよい炭素数1～4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、t e r t-ブチル基等が、炭素数1～4のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、t e r t-ブトキシ基等が、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基としては、フェニル基、トリル基、p-t e r t-ブトキシフェニル基、p-アセチルフェニル基、p-ニトロフェニル基等が、炭素数3～5のヘテロ芳香族基としては、ピリジル基、フリル基等が挙げられる。

【0080】

具体的には、例えばトリフルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-t e r t-ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸(p-t e r t-ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-t e r t-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオロ

メタンスルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-ノルボニル) メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-ノルボニル) メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート]、1, 2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (キシレンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (s e c-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソアミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (s e c-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (t

e r t-アミルスルホニル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1- (t e r t-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1- (t e r t-アミルスルホニル) ジアゾメタン、1-t e r t-アミルスルホニル-1- (t e r t-ブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジフェニルグリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (メタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (トリフルオロメタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (1, 1, 1-トリフルオロエタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (t e r t-ブタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (パーフルオロオクタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (シクロヘキサンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (ベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-フルオロベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-t e r t-ブチルベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (キレンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (カンファースルホニル) - α -ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン、ビストリフルオロメチルスルホニルメタン、ビスマチルスルホニルメタン、ビスエチルスルホニルメタン、ビスプロピルスルホニルメタン、ビスイソプロピルスルホニルメタン、ビス-p-トルエンスルホニルメタン、ビスベニゼンスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、2-シクロヘキシルカルボニ

ル-2- (p-トルエンスルホニル) プロパン、2-イソプロピルカルボニル-2- (p-トルエンスルホニル) プロパン等のβ-ケトスルホン誘導体、p-トルエンスルホン酸2, 6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホン酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1, 2, 3-トリス(メタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1, 2, 3-トリス(トリフルオロメタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1, 2, 3-トリス(p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、N-ヒドロキシスクシニミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミドエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド1-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド2-ペンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド1-オクタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミドp-トルエンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミドp-メトキシベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド2-クロロエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド-2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド1-ナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシニミド2-ナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-2-フェニルスクシニミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-2-フェニルマレイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドメタ

ンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドp-トルエンスルホン酸エステル等のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-ノルボニル) メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、1, 2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (s-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (t-tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、N-ヒドロキシスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ペンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-トルエンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタ

ルイミドベンゼンスルホン酸エステル等のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体が好ましく用いられる。

【0081】

なお上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることによりプロファイルの微調整を行うことが可能である。

【0082】

酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部（重量部、以下同様）に対して好ましくは0.1～50部、より好ましくは0.5～40部である。0.1部より少ないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像力が劣る場合があり、50部を超えるとレジストの透過率が低下し、解像力が劣る場合がある。

【0083】

(D) 成分の塩基性化合物としては、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適している。塩基性化合物の配合により、レジスト膜中の酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向上することができる。

【0084】

このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0085】

具体的には、第一級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチルアミン、sec-ブチルアミン、tert-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミルアミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク

ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペنتアミン等が例示され、第二級の脂肪族アミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジ-n-ブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジ-s e c-ブチルアミン、ジペンチルアミン、ジシクロペんチルアミン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N-ジメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレンジアミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペنتアミン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ-n-プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリ-n-ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリ-s e c-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペんチルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリセチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテトラエチレンペنتアミン等が例示される。

【0086】

また、混成アミン類としては、例えばジメチルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類の具体例としては、アニリン誘導体（例えばアニリン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニトロアニリン、2, 4-ジニトロアニリン、2, 6-ジニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等）、ジフェニル（p-トリル）アミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルアミ

ン、ジアミノナフタレン、ピロール誘導体（例えばピロール、2H-ピロール、1-メチルピロール、2, 4-ジメチルピロール、2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等）、オキサゾール誘導体（例えばオキサゾール、イソオキサゾール等）、チアゾール誘導体（例えばチアゾール、イソチアゾール等）、イミダゾール誘導体（例えばイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール等）、ピラゾール誘導体、フラザン誘導体、ピロリン誘導体（例えばピロリン、2-メチル-1-ピロリン等）、ピロリジン誘導体（例えばピロリジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチルピロリドン等）、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導体、ピリジン誘導体（例えばピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピリジン、4-(1-ブチルペンチル)ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等）、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体（例えばキノリン、3-キノリンカルボニトリル等）、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、ブテリジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1, 10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0087】

更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン酸、アミノ酸誘導体（例えばニコチン酸、アラニン、アルギ

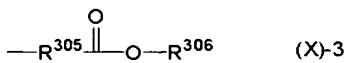
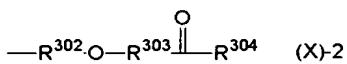
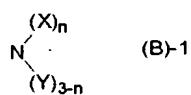
ニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシアラニン) 等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ピリジニウム等が例示され、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、2, 2'-イミノジエタノール、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリジン、1-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン、1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチル) ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3-ピペリジノ-1, 2-プロパンジオール、3-ピロリジノ-1, 2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル) フタルイミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチニアミド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベニズアミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイイミド等が例示される。

【0088】

更に下記一般式 (B) - 1 で示される塩基性化合物から選ばれる 1 種又は 2 種以上を添加することもできる。

【0089】

【化40】



【0090】

式中、 $n = 1, 2$ 又は 3 である。側鎖 X は同一でも異なっていてもよく、下記一般式 $(X)-1 \sim (X)-3$ で表すことができる。側鎖 Y は同一又は異種の、水素原子、又は直鎖状、分岐状又は環状の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基を示し、エーテル基もしくはヒドロキシル基を含んでもよい。また、 X 同士が結合して環を形成してもよい。

【0091】

ここで R^{300} 、 R^{302} 、 R^{305} は炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、 R^{301} 、 R^{304} は水素原子、炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル基、エステル基、ラクトン環を 1 あるいは複数含んでいてもよい。

R^{303} は単結合、炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、 R^{306} は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル、エステル基、ラクトン環を 1 あるいは複数含んでいてもよい。

【0092】

一般式 $(B)-1$ で表される化合物は具体的には下記に例示される。

トリス(2-メトキシメトキシエチル)アミン、トリス{2-(2-メトキシエトキシ)エチル}アミン、トリス{2-(2-メトキシエトキシメトキシ)エチル}アミン、トリス{2-(1-メトキシエトキシ)エチル}アミン、トリス{2-(1-エトキシエトキシ)エチル}アミン、トリス{2-(1-エトキシプロポキシ)エチル}アミン、トリス[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]アミン、

トキシ| エチル] アミン、4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサ-1, 10-ジアザビシクロ [8. 8. 8] ヘキサコサン、4, 7, 13, 18-テトラオキサ-1, 10-ジアザビシクロ [8. 5. 5] エイコサン、1, 4, 10, 13-テトラオキサ-7, 16-ジアザビシクロオクタデカン、1-アザ-12-クラウン-4、1-アザ-15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6、トリス (2-フォルミルオキシエチル) アミン、トリス (2-ホルミルオキシエチル) アミン、トリス (2-アセトキシエチル) アミン、トリス (2-プロピオニルオキシエチル) アミン、トリス (2-ブチリルオキシエチル) アミン、トリス (2-イソブチリルオキシエチル) アミン、トリス (2-バレリルオキシエチル) アミン、トリス (2-ピバロイルオキシエチル) アミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (アセトキシアセトキシ) エチルアミン、トリス (2-メトキシカルボニルオキシエチル) アミン、トリス (2-tert-ブトキシカルボニルオキシエチル) アミン、トリス [2- (2-オキソプロポキシ) エチル] アミン、トリス [2- (メトキシカルボニルメチル) オキシエチル] アミン、トリス [2- (tert-ブトキシカルボニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス [2- (シクロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス (2-メトキシカルボニルエチル) アミン、トリス (2-エトキシカルボニルエチル) アミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (メトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (メトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (エトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (エトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (エトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-メトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (2-メトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- [(メトキシカルボニル) メトキシカルボニル] エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- [(メトキシカルボニル) メトキシカ

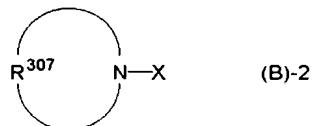
ルボニル] エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル) 2-(2-オキソプロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル) 2-(2-オキソプロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル) 2-(テトラヒドロフルフリルオキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル) 2-(テトラヒドロフルフリルオキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル) 2-[(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) オキシカルボニル] エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル) 2-[(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) オキシカルボニル] エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル) 2-(4-ヒドロキシブロキカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル) 2-(4-ホルミルオキシブロキカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル) 2-(2-ホルミルオキシエトキカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-メトキシエチル) 2-(メトキシカルボニル) エチルアミン、N-(2-ヒドロキシエチル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-アセトキシエチル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-ヒドロキシエチル) ビス[2-(エトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-ヒドロキシ-1-プロピル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-アセトキシ-1-プロピル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-メトキシエチル) ビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-ブチルビス[2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-ブチルビス[2-(2-メトキシエトキカルボニル) エチル] アミン、N-メチルビス(2-アセトキシエチル) アミン、N-エチルビス(2-アセトキシエチル) アミン、N-メチルビス(2-ピバロイルオキシキシエチル) アミン、N-エチルビス[2-(メトキシカルボニルオキシ) エチル] アミン、N-エチルビス[2-(tert-ブロキシカルボニルオキシ) エチル] アミン、トリス(メトキシカルボニルメチル) アミン、トリス(エトキシカルボニルメチル) アミン、N-ブチルビス(メトキシカルボニルメチル) アミン、N-ヘキシ

ルビス（メトキシカルボニルメチル）アミン、 β -（ジエチルアミノ）- δ -バレロラクトンを例示できるが、これらに制限されない。

更に下記一般式（B）-2に示される環状構造を持つ塩基化合物の1種あるいは2種以上を添加することもできる。

【0093】

【化41】



（式中、Xは前述の通り、R³⁰⁷は炭素数2～20の直鎖状又は分岐状のアルキレン基であり、カルボニル基、エーテル基、エステル基、又はスルフィドを1個あるいは複数個含んでいてもよい。）

【0094】

B-2は具体的には、1-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ピロリジン、1-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ピペリジン、4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]モルホリン、1-[2-[2-(メトキシエトキシ)メトキシ]エチル]ピロリジン、1-[2-[2-(メトキシエトキシ)メトキシ]エチル]ピペリジン、4-[2-[2-(メトキシエトキシ)メトキシ]エチル]モルホリン、酢酸2-(1-ピロリジニル)エチル、酢酸2-ピペリジノエチル、酢酸2-モルホリノエチル、ギ酸2-(1-ピロリジニル)エチル、プロピオン酸2-ピペリジノエチル、アセトキシ酢酸2-モルホリノエチル、メトキシ酢酸2-(1-ピロリジニル)エチル、4-[2-(メトキシカルボニルオキシ)エチル]モルホリン、1-[2-(t-ブトキシカルボニルオキシ)エチル]ピペリジン、4-[2-(2-メトキシエトキシカルボニルオキシ)エチル]モルホリン、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸メチル、3-ピペリジノプロピオン酸メチル、3-モルホリノプロピオン酸メチル、3-(チオモルホリノ)プロピオン酸メチル、2-メチル-3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸メチル、3-モルホリノプロピオン酸エチル、3-ピペリジノプロピオン酸メトキシカルボニルメチル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-ヒドロキシエチル、

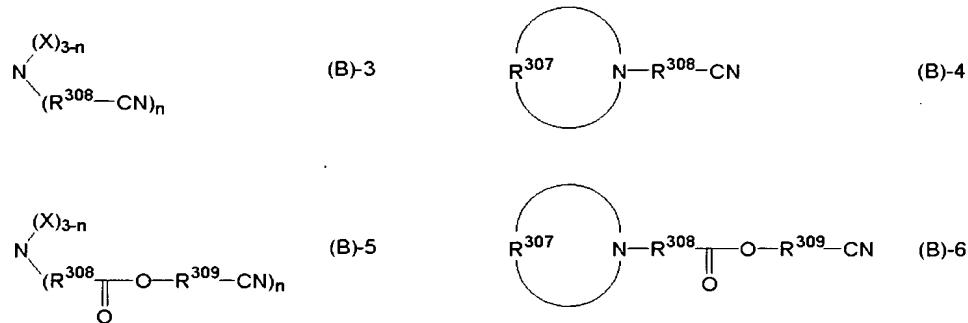
3-モルホリノプロピオン酸2-アセトキシエチル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル、3-モルホリノプロピオン酸テトラヒドロフルフリル、3-ピペリジノプロピオン酸グリシル、3-モルホリノプロピオン酸2-メトキシエチル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-(2-メトキシエトキシ)エチル、3-モルホリノプロピオン酸ブチル、3-ピペリジノプロピオン酸シクロヘキシル、 α -(1-ピロリジニル)メチル- γ -ブチロラクトン、 β -ピペリジノ- γ -ブチロラクトン、 β -モルホリノ- δ -バレロラクトン、1-ピロリジニル酢酸メチル、ピペリジノ酢酸メチル、モルホリノ酢酸メチル、チオモルホリノ酢酸メチル、1-ピロリジニル酢酸エチル、モルホリノ酢酸2-メトキシエチルで挙げることができる。

〔0095〕

更に、下記一般式 (B) - 3 ~ (B) - 6 で表されるシアノ基を含む塩基化合物を添加することができる。

[0096]

【化 4 2】



(式中、X、R³⁰⁷、nは前述の通り、R³⁰⁸、R³⁰⁹は同一又は異種の炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキレン基である。)

[0097]

シアノ基を含む塩基は、具体的には3-(ジエチルアミノ)プロピオノトリル、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノトリル、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)-3-アミノプロピオノトリル、N,N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロピオノトリル、N,N-ビス(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオノトリル、N,N-ビ

ス [2-(メトキシメトキシ)エチル]-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(3-ヒドロキシ-1-プロピル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(3-アセトキシ-1-プロピル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(3-ホルミルオキシ-1-プロピル)-3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-テトラヒドロフルフリル-3-アミノプロピオノニトリル、N, N-ビス(2-シアノエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、ジエチルアミノアセトニトリル、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノアセトニトリル、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)アミノアセトニトリル、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)アミノアセトニトリル、N, N-ビス(2-メトキシエチル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-シアノメチル-N-(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキシエチル)-N-シアノメチル-3-アミノプロピオン酸メチル、N-シアノメチル-N-(2-ヒドロキシエチル)アミノアセトニトリル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(シアノメチル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-ホルミルオキシエチル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル)

アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-[2-(メトキシメトキシ)エチル]アミノアセトニトリル、N-(シアノメチル)-N-(3-ヒドロキシ-1-プロピル)アミノアセトニトリル、N-(3-アセトキシ-1-プロピル)-N-(シアノメチル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(3-ホルミルオキシ-1-プロピル)アミノアセトニトリル、N, N-ビス(シアノメチル)アミノアセトニトリル、1-ピロリジンプロピオノニトリル、1-ピペリジンプロピオノニトリル、4-モルホリンプロピオノニトリル、1-ピロリジンアセトニトリル、1-ピペリジンアセトニトリル、4-モルホリンアセトニトリル、3-ジエチルアミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス[2-(メトキシメトキシ)エチル]-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、3-ジエチルアミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、N, N-ビス[2-(メトキシメトキシ)エチル]-3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、1-ピロリジンプロピオン酸シアノメチル、1-ピペリジンプロピオン酸シアノメチル、4-モルホリンプロピオン酸シアノメチル、1-ピロリジンプロピオン酸(2-シアノエチル)、1-ピペリジンプロピオン酸(2-シアノエチル)、4-モルホリンプロピオン酸(2-シアノエチル)が例示される。

【0098】

なお、塩基性化合物の配合量は全ベース樹脂100部に対して0.001~2部、特に0.01~1部が好適である。配合量が0.001部より少ないと配合効果がなく、2部を超えると感度が低下しすぎる場合がある。

【0099】

(E) 成分の溶解阻止剤としては、重量平均分子量が100～1,000で、かつ分子内にフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として平均10～100モル%の割合で置換した化合物が好ましい。

【0100】

このような好適に用いられる溶解阻止剤の例としては、ビス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(2'-テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-tert-ブトキシフェニル)メタン、ビス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)メタン、ビス(4-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル)メタン、ビス(4-(1'-エトキシエトキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、2,2-ビス(4'-(2',-テトラヒドロピラニルオキシ)プロパン、2,2-ビス(4'-(2',-テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシエトキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシプロピルオキシ)フェニル)プロパン、4,4-ビス(4'-(2',-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-(2',-テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-tert-ブトキシエトキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-tert-ブトキシプロピルオキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、トリス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、トリス(4-(2'-テトラヒ

ドロフラニルオキシ) フェニルメタン、トリス (4-tert-ブトキシフェニル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタン、トリス (4-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル) メタン、トリス (4-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル) メタン、1,1,2-トリス (4'-(2'-(テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-(2'-(テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-(tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-(1'-エトキシエトキシ) フェニル) エタン、1,1,2-トリス (4'-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル) エタン等が挙げられる。

【0101】

なお、上記化合物の重量平均分子量は100～1,000、好ましくは150～800である。

溶解阻止剤の配合量は、ベース樹脂100重量部に対して0～50重量部、好ましくは5～50重量部、より好ましくは10～30重量部であり、単独又は2種以上を混合して使用できる。配合量が少ないと解像性の向上がない場合があり、多すぎるとパターンの膜減りが生じ、解像度が低下する傾向がある。

【0102】

本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0103】

界面活性剤の例としては、特に限定されるものではないが、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレインエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキ

シエチレンノニルフェノール等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類
、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタン
モノラウレート、ソルビタンモノバルミテート、ソルビタンモノステアレート等
のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート
、ポリオキシエチレンソルビタンモノバルミテート、ポリオキシエチレンソルビ
タンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオ
キシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂
肪酸エステルのノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF303、E
F352（トーケムプトダクツ社製）、メガファックF171、F172、F1
73（大日本インキ化学工業社製）、フロードFC430、FC431（住友
スリーエム社製）、アサヒガードAG710、サーフロンS-381、S-38
2、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC10
6、サーフィノールE1004、KH-10、KH-20、KH-30、KH-
40（旭硝子社製）等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP
-341、X-70-092、X-70-093（信越化学工業社製）、アクリ
ル酸系又はメタクリル酸系ポリフローNo. 75, No. 95（共栄社油脂化学
工業社製）が挙げられ、中でもFC430、サーフロンS-381、サーフィノ
ールE1004、KH-20、KH-30が好適である。これらは単独あるいは
2種以上の組み合わせで用いることができる。

【0104】

本発明のレジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフ
ィー技術を採用して行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上にス
ピンコーティング等の手法で膜厚が0.1～1.0 μm となるように塗布し、こ
れをホットプレート上で60～200°C、10秒～10分間、好ましくは80～
150°C、30秒～5分間プリベークする。次いで目的のパターンを形成するた
めのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線
等の高エネルギー線もしくは電子線を露光量1～200mJ/cm²程度、好ま
しくは10～100mJ/cm²程度となるように照射した後、ホットプレート
上で60～150°C、10秒～5分間、好ましくは80～130°C、30秒～3

分間ポストエクスピージャベーク（P E B）する。更に、0. 1～5%、好ましくは2～3%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）等のアルカリ水溶液の現像液を用い、10秒～3分間、好ましくは30秒～2分間、浸漬（d i p）法、パドル（p u d d l e）法、スプレー（s p r a y）法等の常法により現像することにより基板上に目的のパターンが形成される。

【0105】

本発明のレジスト材料は、特に高エネルギー線の中でも254～120nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、特に193nmのArF、157nmのF₂、146nmのKr₂、134nmのKrAr、126nmのAr₂等のレーザー、X線及び電子線による微細パターンニングに最適である。とりわけ、波長100～180nm帯又は1～30nm帯の高エネルギー線（F₂レーザー、Ar₂レーザー、軟X線レーザー）で露光することがよい。なお、上記範囲の上限及び下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることができない場合がある。

【0106】

【発明の効果】

本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200nm以下の波長における透明性を損なうことなく、アルカリ溶解性コントラストと優れたプラズマエッチング耐性を有することがわかった。従って本発明のレジスト材料は、これらの特性により、特にF₂レーザー露光における微細でしかも基板に対してアスペクト比の高い垂直なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適であることを特徴とする。

【0107】

【実施例】

以下、高分子化合物の合成例とレジスト材料の評価例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

ポリマー合成例

[合成例1] 下記モノマー1、モノマー2、及びモノマー3の共重合（0.2:0.2:0.6）

300mLのフラスコ中に下記モノマー1を5.03g、モノマー2を5.5

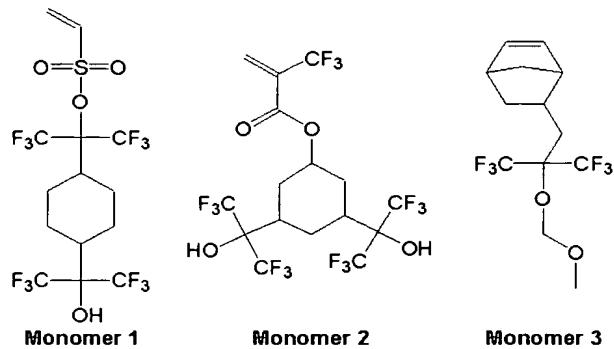
0 g、モノマー-3を9. 48 g仕込み、1, 4-ジオキサン5. 0 gに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0. 41 g仕込み、65℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0108】

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフラン（以下、THFと略記）に溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた12. 9 gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が5, 800であり、GPC溶出曲線より分散度（=Mw/Mn）が1. 5の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは¹H-NMRの測定結果より、モノマー1：モノマー2：モノマー3に由来する単位のモル比が0. 21：0. 19：0. 60であることがわかった。

【0109】

【化43】



【0110】

【合成例2】 モノマー1、モノマー2及び下記モノマー4の共重合（0.2：0.2：0.6）

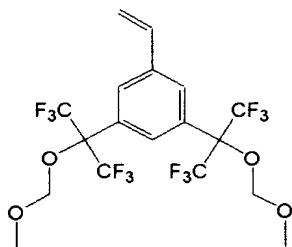
300mLのフラスコ中にモノマー1を3. 85 g、モノマー2を4. 21 g、下記モノマー4を11. 95 g仕込み、1, 4-ジオキサン5. 0 gに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0. 31 g仕込み、65℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0111】

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈殿させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈殿させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた12.7gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が8,700であり、GPC溶出曲線より分散度($=M_w/M_n$)が1.5の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは¹H-NMRの測定結果より、モノマー1：モノマー2：モノマー4に由来する単位のモル比が0.21：0.21：0.58であることがわかった。

【0112】

【化44】



Monomer 4

【0113】

【合成例3】 モノマー1、モノマー2、モノマー3及び下記モノマー5の共重合(0.1:0.1:0.6:0.2)

300mLのフラスコ中にモノマー1を3.01g、モノマー2を3.30g、モノマー3を11.36g、下記モノマー5を2.33g仕込み、1,4-ジオキサン5.0gに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.49g仕込み、65℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

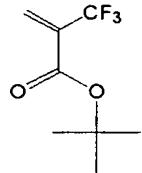
【0114】

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈殿させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈殿させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.9gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が5,800であり、GPC溶出曲線より分散度($=M_w/M_n$)

) が 1. 4 の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1\text{H-NMR}$ の測定結果より、モノマー 1 : モノマー 2 : モノマー 3 : モノマー 5 に由来する単位のモル比が 0. 08 : 0. 10 : 0. 59 : 0. 23 であることがわかった。

【0115】

【化45】



Monomer 5

【0116】

[合成例4] モノマー 1、モノマー 2、モノマー 4 及びモノマー 5 の共重合 (0. 2 : 0. 1 : 0. 5 : 0. 2)

300 mL のフラスコ中にモノマー 1 を 5. 63 g、モノマー 2 を 3. 08 g、モノマー 4 を 5. 83 g、モノマー 5 を 5. 46 g 仕込み、1, 4-ジオキサン 5. 0 g に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤 AIBN を 0. 46 g 仕込み、65 °C まで昇温して 24 時間重合反応を行った。

【0117】

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン 1 L に注ぎ、得られた重合体を沈殿させた。更に得られたポリマーを THF に溶かし、ヘキサン 1 L 中に注いでポリマーを沈殿させる操作を 2 回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた 12. 2 g の白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が 8, 800 であり、GPC 溶出曲線より分散度 ($= M_w / M_n$) が 1. 4 の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1\text{H-NMR}$ の測定結果より、モノマー 1 : モノマー 2 : モノマー 4 : モノマー 5 に由来する単位のモル比が 0. 18 : 0. 11 : 0. 52 : 0. 19 であることがわかった。

【0118】

[評価例]

ポリマー透過率測定

得られたポリマー1 gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(以下、PGMEAと略記)20 gに十分に溶解させ、0.2 μ mのフィルターで濾過してポリマー溶液を調整した。

【0119】

比較例用ポリマーとして、分子量10,000、分散度($=M_w/M_n$)1.1の単分散ポリヒドロキシスチレンの水酸基の30%をテトラヒドロピラニル基で置換したポリマーを用意し、これを比較例用ポリマー1とした。同様に、分子量15,000、分散度1.7のポリメチルメタクリレートを比較例用ポリマー2、メタ/パラ比40/60で分子量9,000、分散度2.5のノボラックポリマーを比較例用ポリマー3とし、上記と同様の方法でポリマー溶液を調製した。

【0120】

ポリマー溶液をMgF₂基板にスピンドルコートして塗布後、ホットプレートを用いて100°Cで90秒間ベークし、厚さ100 nmのポリマー膜をMgF₂基板上に作成した。この基板を真空紫外光度計(日本分光社製、VUV-200S)に設置し、248 nm、193 nm、157 nmにおける透過率を測定した。測定結果を表1に示す。表1より本発明の高分子化合物を用いたレジスト材料は、F₂(157 nm)の波長においても十分な透明性を確保できることがわかった。

【0121】

【表1】

ポリマー	透過率(%) 248nm	透過率(%) 193nm	透過率(%) 157nm
ポリマー1	99	93	74
ポリマー2	99	5	69
ポリマー3	99	94	71
ポリマー4	99	8	67
比較例1ポリマー	90	5	15
比較例2ポリマー	91	80	12
比較例3ポリマー	82	6	17

【0122】

レジスト調製及び露光

ポリマー、酸発生剤、塩基、溶解阻止剤を表2に示す量で1000重量部のPGMEA中で混合し、常法によりレジスト液を調製した。

【0123】

次に、DUV-30 (Brewer Science社製) を85nmの膜厚で製膜したシリコンウェハー上に、得られたレジスト液をスピンドルコート後、ホットプレートを用いて120°Cで90秒間ベークし、レジストの厚みを100nmの厚さにした。

【0124】

このウェハーにF₂レーザーVUVES-4500 (リソテックジャパン社製) で露光量を変化させながら露光し、露光後直ちに120°Cで90秒間ベークし (PEB) 、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行って、露光量と残膜率の関係を求めた。膜厚が0になった露光量をE_{th}として、レジストの感度、そのときの傾きのtanθをγとして求めた。

【0125】

また、MgF₂基板にCrパターンを形成したマスクを使い、レジスト膜とCrパターン面とを密着させてF₂レーザーを照射し、密着露光を行った。露光後、上記と同様にPEB、現像を行い、パターン形成を行った。パターンの断面をSEM観察し、形成できた最小のパターンを解像度とした。

【0126】

VUVES露光の結果、露光量の増大に従って膜厚が減少し、高い γ 値を有する高コントラストなポジ型レジストの特性を示し、密着露光での解像力も高いことがわかった。

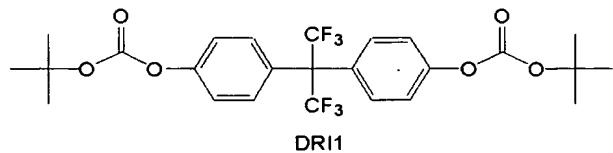
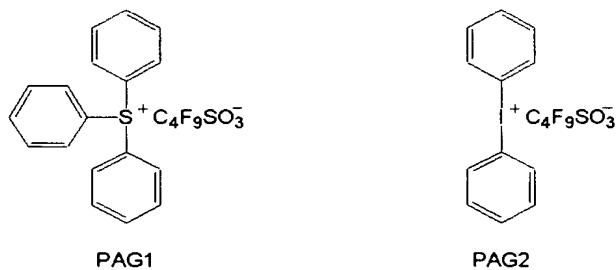
【0127】

【表2】

ポリマー (重量部)	酸発生剤 (重量部)	塩基 (重量部)	溶解阻止剤 (重量部)	溶媒 (重量部)	Eth感度 (mJ/cm ²)	γ
合成例1 (100)	PAG1 (4)	トリブチルアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	18	8.9
合成例2 (100)	PAG1 (4)	トリブチルアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	16	10.5
合成例3 (100)	PAG1 (4)	トリブチルアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	10	10.7
合成例4 (100)	PAG1 (4)	トリブチルアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	7	9.3
合成例3 (100)	PAG1 (4)	トリエタノールアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	12	10.1
合成例3 (100)	PAG1 (4)	トリブチルアミン (0.1)	DRI1 (10)	PGMEA (1,000)	9	10.0
合成例3 (100)	PAG2 (4)	トリブチルアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	10	12.7
比較例ポリ マー1 (100)	PAG1 (4)	トリエタノールアミン (0.1)	—	PGMEA (1,000)	感度なし、膜厚 が0nmまで減少 せずにネガ化	—

【0128】

【化46】



【0129】

ドライエッティング耐性試験

ドライエッティング耐性の試験では、ポリマー2 gをPGMEA 10 gに溶解させ、0.2 μ mサイズのフィルターで濾過後、シリコン基板上にスピンドルコートで300 nmの厚さに製膜し、次の2系統の条件で評価した。CHF₃/CF₄系ガスでのエッティング試験では、ドライエッティング装置TE-8500P（東京エレクトロン社製）を用い、Cl₂/BCl₃系ガスでのエッティング試験では、ドライエッティング装置L-507D-L（日電アネルバ社製）を用い、それぞれエッティング前後のポリマー膜の膜厚差を求めた。エッティング条件を表3、その結果を表4に示す。

【0130】

表4より、本発明のレジスト材料はエッティング耐性にも優れることがわかった。

【0131】

【表3】

	CHF ₃ /CF ₄ 系	Cl ₂ /BCl ₃ 系
チャンバー圧力(Pa)	40.0	40.0
RFパワー(W)	1,300	300
ギャップ(mm)	9	9
ガス流量(ml/min)	CHF ₃ :30 CF ₄ :30 Ar:100	Cl ₂ :30 BCl ₃ :30 CHF ₃ :100 O ₂ :2
時間(sec)	30	30

【0132】

【表4】

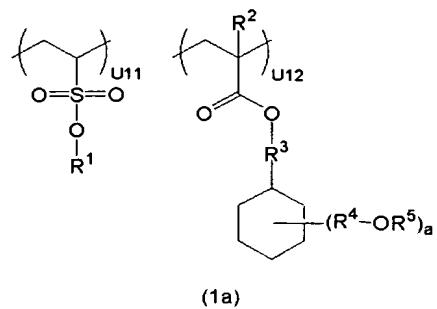
ポリマー名	CHF ₃ /CF ₄ 系ガス エッティング速度 (nm/min.)	Cl ₂ /BCl ₃ 系ガス エッティング速度 (nm/min.)
ポリマー1	220	280
ポリマー2	170	200
ポリマー3	170	200
ポリマー4	190	215

【書類名】 要約書

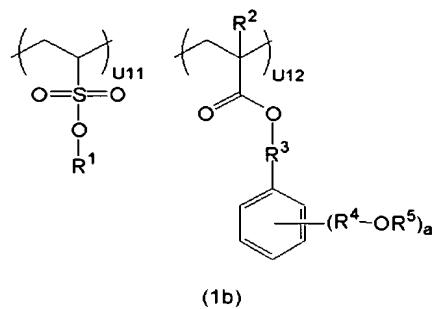
【要約】

【解決手段】 式 (1 a) 又は (1 b) で表される繰り返し単位を含む重量平均分子量 1, 000 ~ 500, 000 の高分子化合物。

【化1】



(1a)



(1b)

(R^1 は酸不安定基、密着性基、又はフッ素化されたアルキル基。 R^2 は水素原子、フッ素原子、又はアルキル基又はフッ素化されたアルキル基。 R^3 及び R^4 は単結合、又はアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基。 R^5 は水素原子又は酸不安定基。 a は1又は2。 $0 < \text{U}_{11} < 1$ 、 $0 < \text{U}_{12} < 1$ 。)

【効果】 本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200 nm以下の波長における透明性を損なうことなく、アルカリ溶解性コントラストと優れたプラズマエッチング耐性を有する。

【選択図】 なし

特願2003-032675

出願人履歴情報

識別番号

[000002060]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

1990年 8月22日

新規登録

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

信越化学工業株式会社

特願2003-032675

出願人履歴情報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住所 大阪府門真市大字門真1006番地
氏名 松下電器産業株式会社

特願2003-032675

出願人履歴情報

識別番号 [000002200]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住所 山口県宇部市大字沖宇部5253番地
氏名 セントラル硝子株式会社